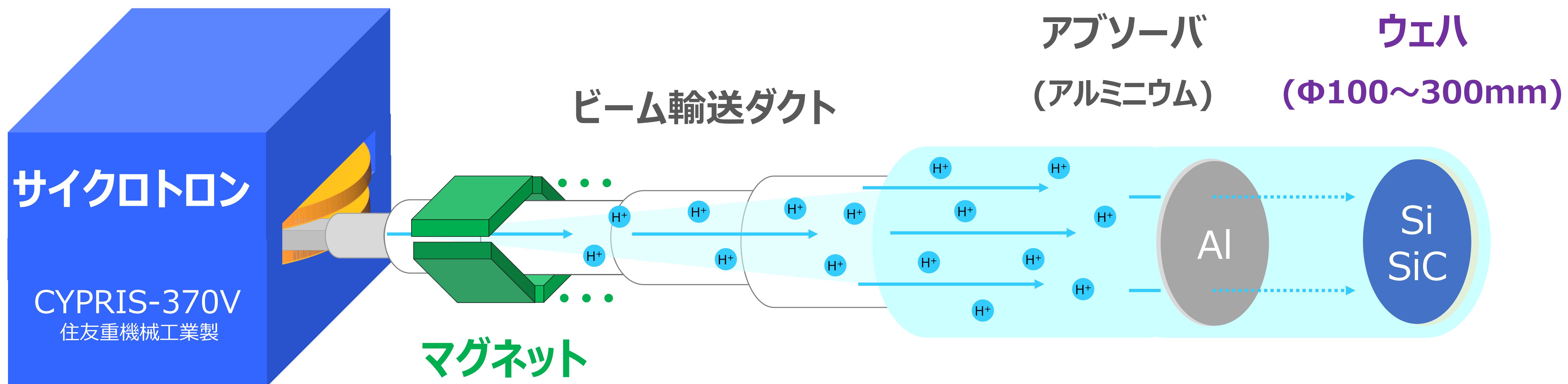


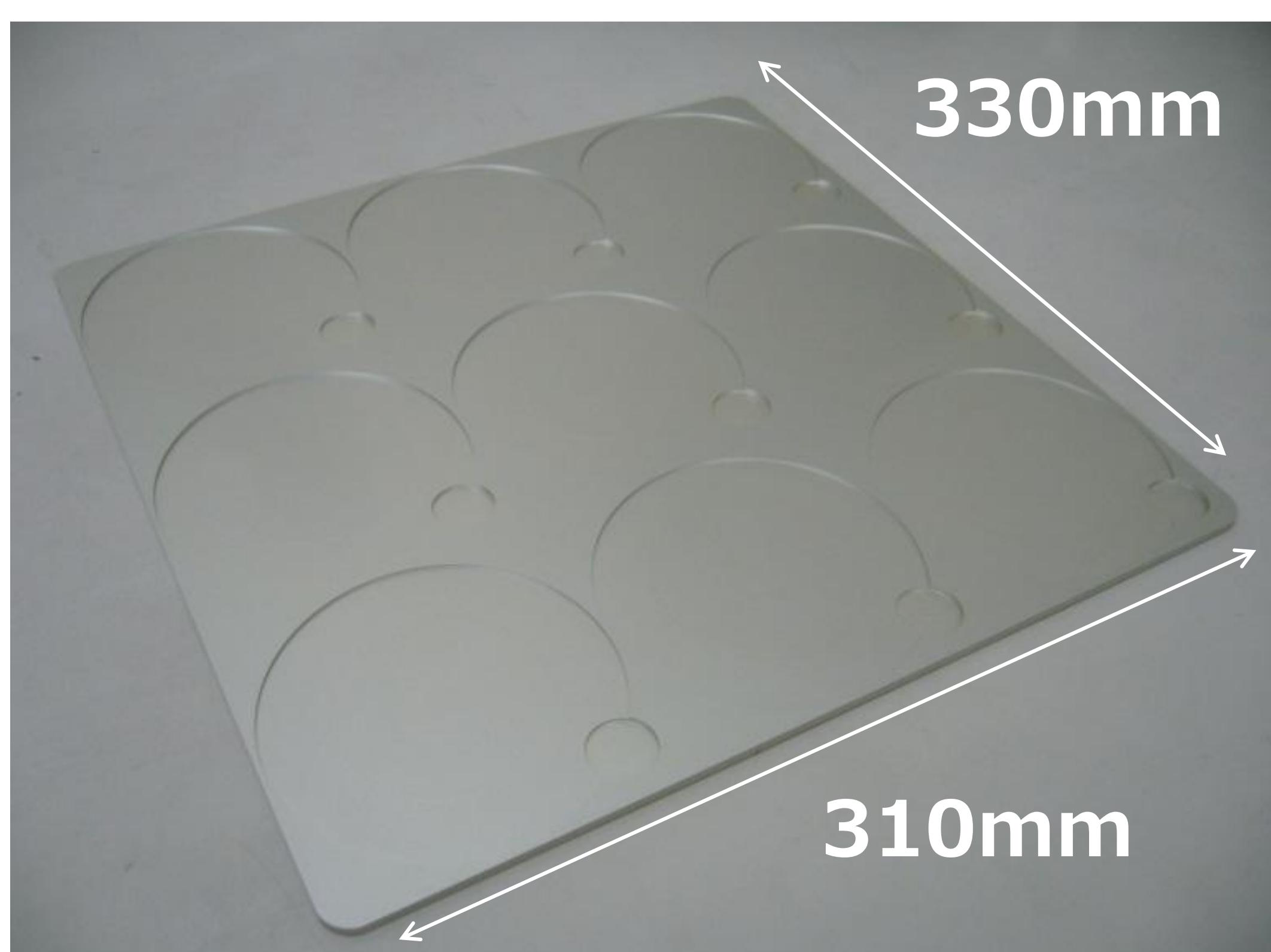
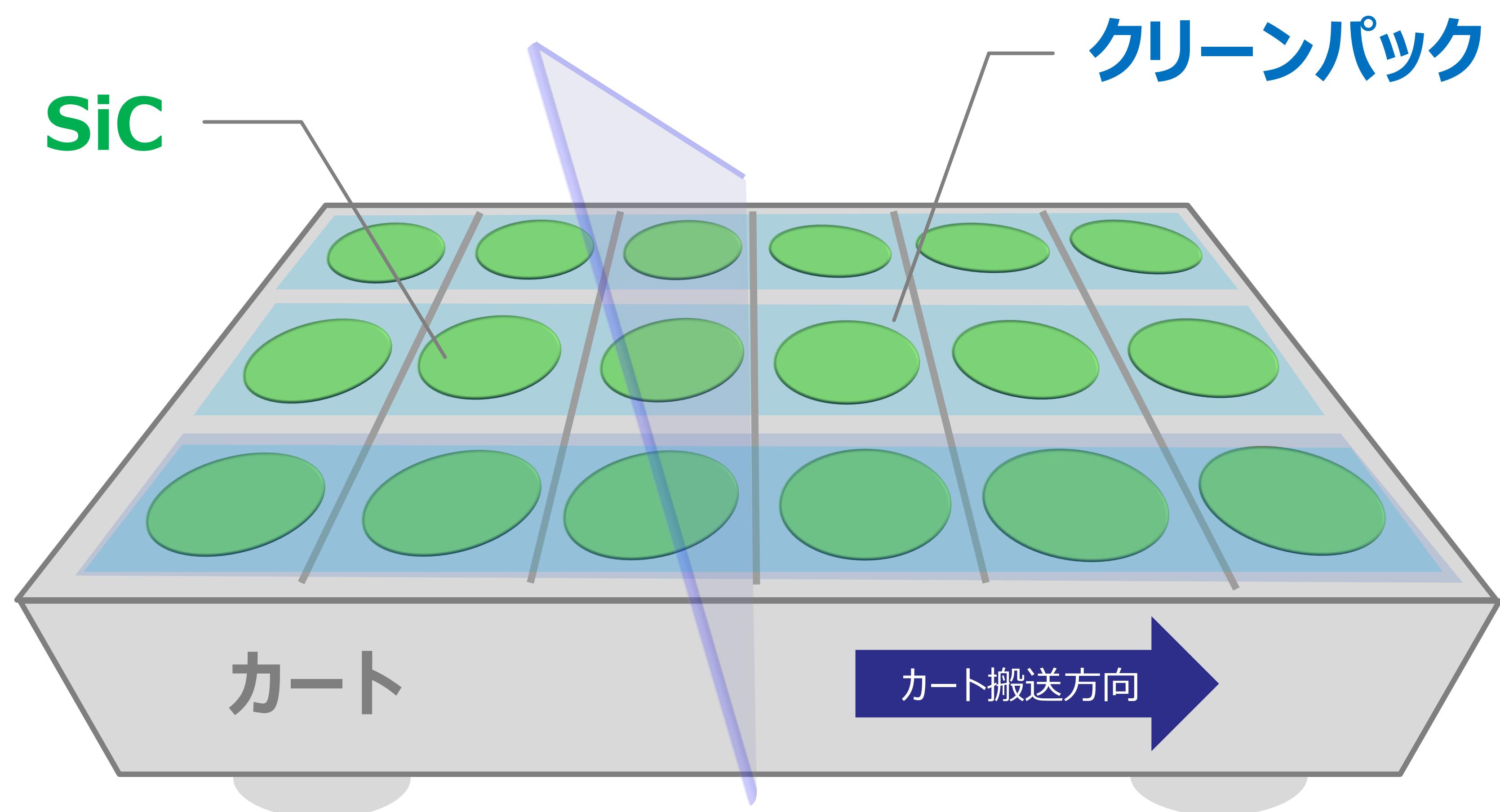
高エネルギーイオン照射サービス



	ガス	イオン	エネルギー	Si中深さ (μm)	FWHM (μm)	SiC中深さ (μm)	FWHM (μm)
サイクロトロン 仕様表	水素	H ⁺	2MeV	0~44	3	0~29	1
		H ⁺	4MeV	0~167	8	0~113	4
		H ⁺	8MeV	0~472	22	0~320	11
	ヘリウム-3	³ He ²⁺	23MeV	0~338	8	0~229	4
	ヘリウム-4	⁴ He ²⁺	17MeV	0~169	4	0~114	2
タンデム 仕様表	水素	H ⁺	0.26~ 2.40MeV	2.5~64	0.2~ 3.0	1.6~43.0	~1.7

高エネルギー電子線照射サービス

電子線ビーム



アルミトレイを用いての照射も可能

電子線照射 仕様表	拠点	エネルギー	1回あたり 照射量	1日あたり 最大照射量	照射可能な 最大サンプルサイズ	カート 台数
	つくば	2.0MeV	3.1E13cm ⁻²	7.8E14cm ⁻²	1,000×1,500mm	24台
	大阪	4.6MeV	5.4E13cm ⁻²	1.4E15cm ⁻²	1,000×1,500mm	37台



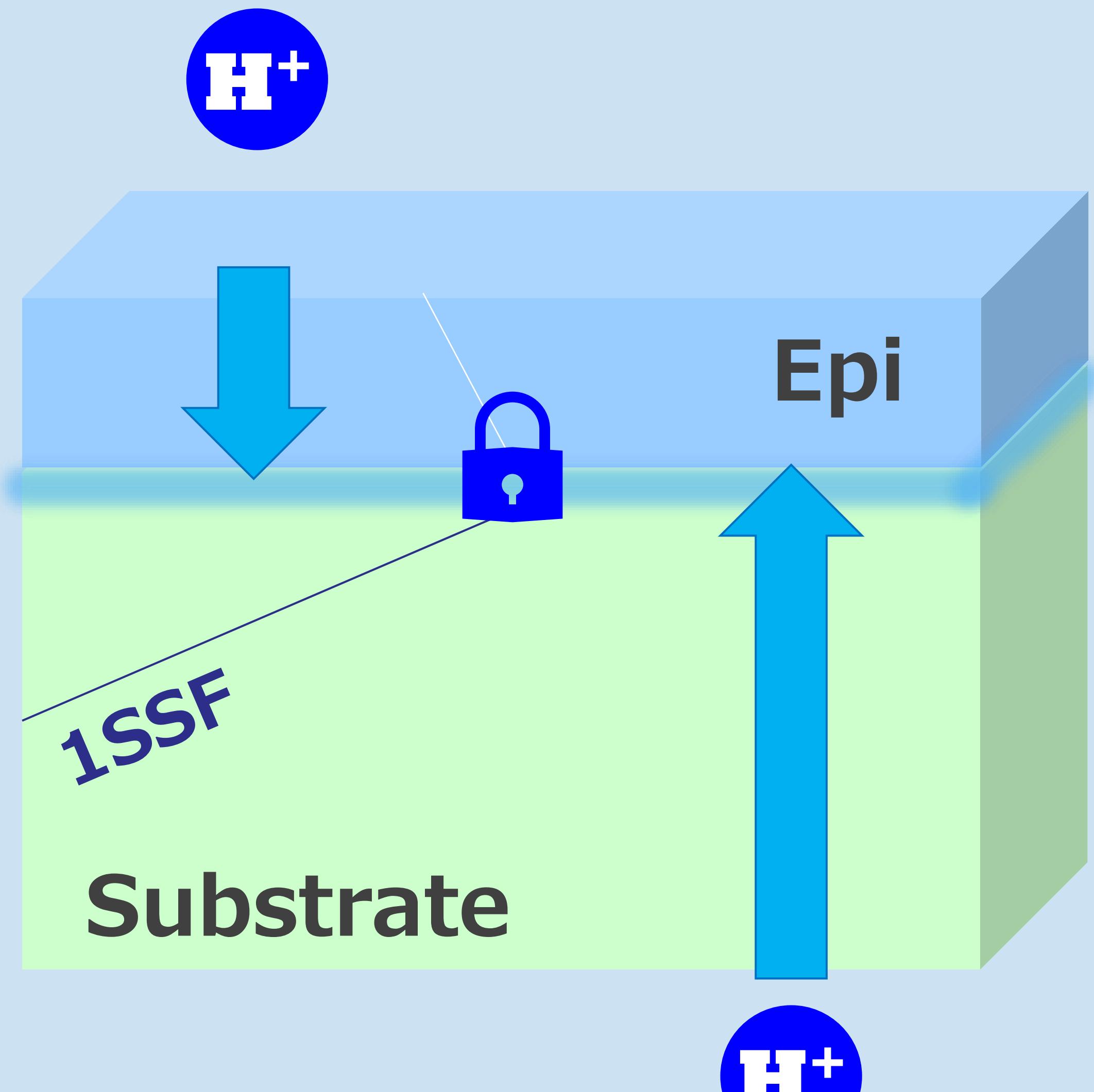
住重アテックス株式会社

SiC積層欠陥拡張の問題を解決！

- ・イオン注入により
積層欠陥拡張の
抑制が可能！

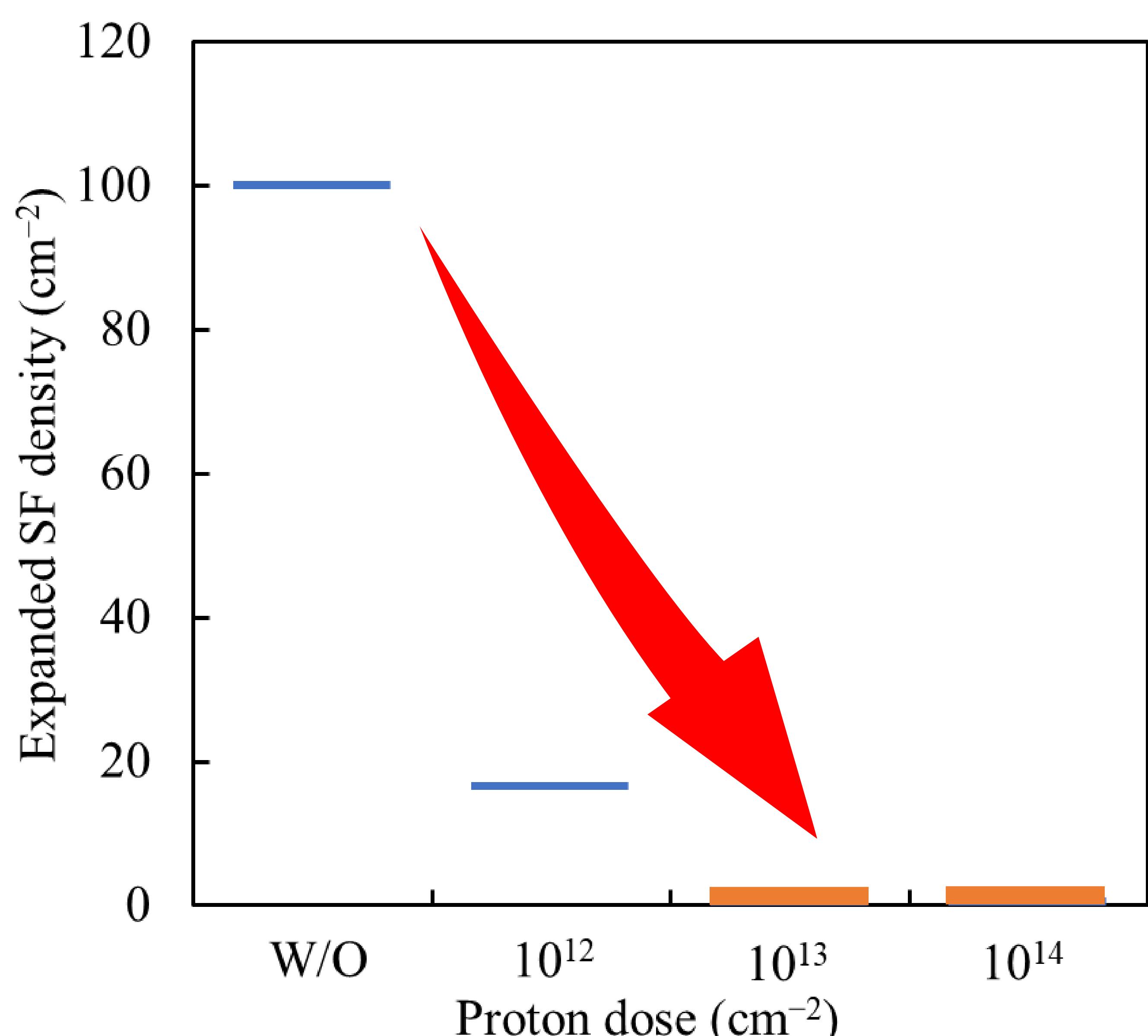
- ・高エネルギーだから
裏面注入も可能！

Low energy !



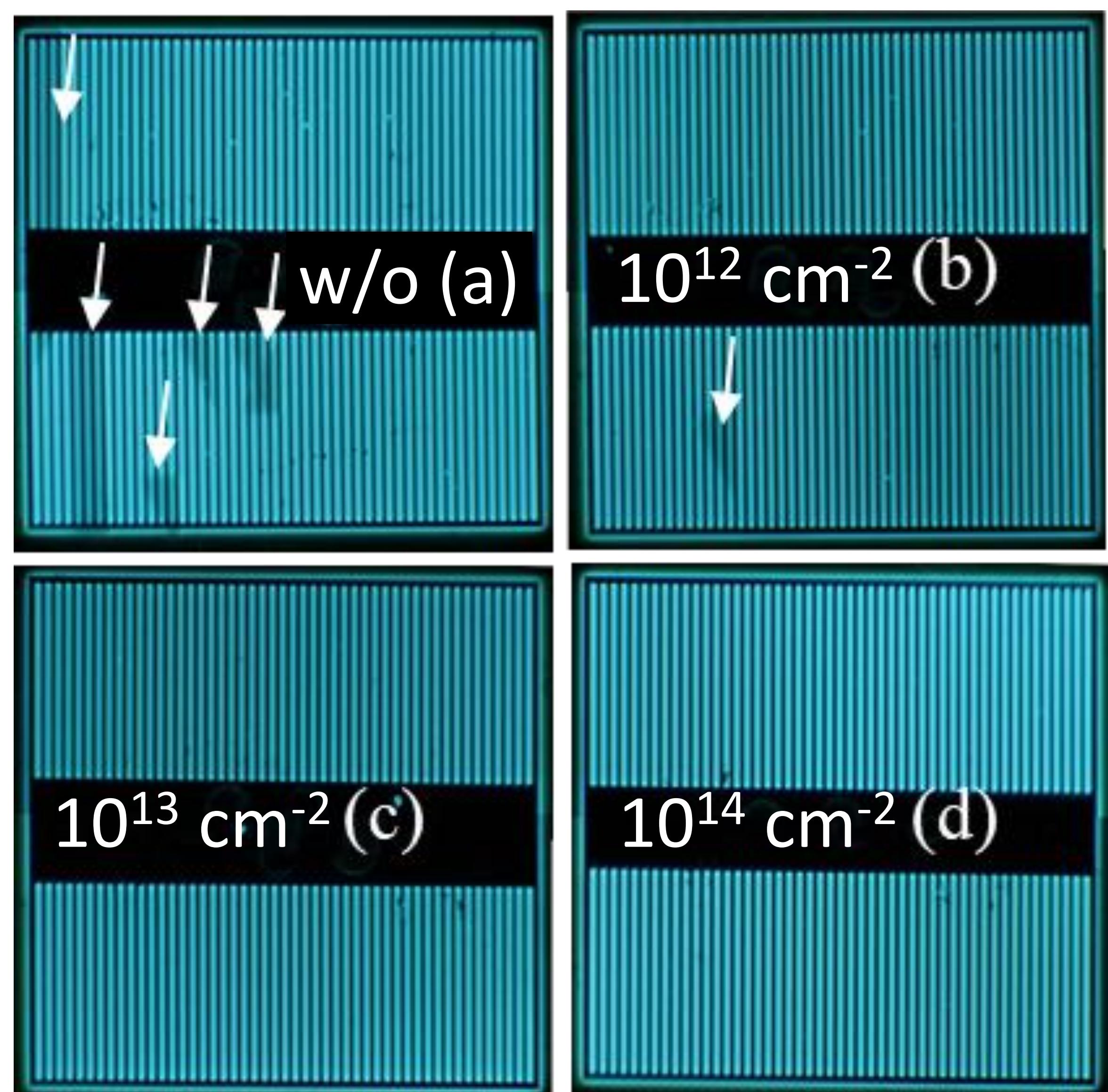
High energy !

積層欠陥の密度比較



10^{12}cm^{-2} 程度の注入量でも抑制効果が得られる事が分かり、 10^{13}cm^{-2} 以上では欠陥の拡張は確認されませんでした。

電流ストレス後のEL像



イオン注入量を増加させることで、暗部（拡張された積層欠陥）の発生を防ぐことができます。

